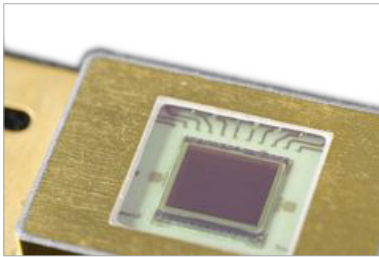


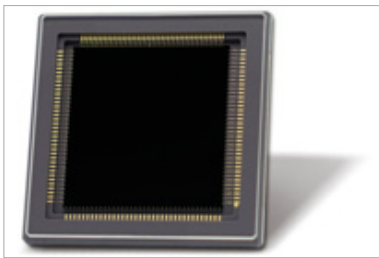
Es gibt Neues!

Verbesserter 2.2 μm InGaAs-matrix sensor



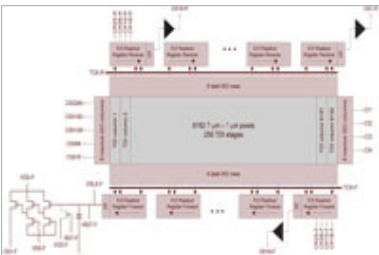
Höhere Fertigungsausbeute für Serien-Verfügbarkeit
320 x 256 Pixel-Auflösung,
1.2 μm - 2.2 μm spektrale Empfindlichkeit
Verbesserte Pixelverfügbarkeit
> 97 % min. (oft 99 % und besser)
Niedriger Dunkelstrom, bessere Signalhomogenität über die Pixel

Wissenschaftlicher 4 k x 4 k Si-CMOS Bildsensor



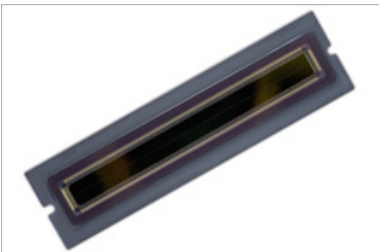
4 k x 4 k Pixelauflösung, 11 μm Pixelgröße
Rückseitenbelichtet: 95 % q.e. bei 850 nm
Ausleserauschen von 1.2 e- bei -50 °C
Bis 48 Hz Ausleserate, bis 96 dB Dynamikbereich

8 k Si-TDI CCD Bildsensor



8192 Bildpunkte, 7 μm x 7 μm Pixel
Bis zu 256 TDI-Stufen selektierbar, bidirektional,
16 Ausgänge, 100 x Antiblooming, > 33 kHz TDI-Rate
Chip auf Träger oder kundenspezifisches Sensorgehäuse

Si-CMOS Linearsensoren



2100 x 1 bis 32.000 x 8 Bildpunkte
5 μm bis zu 14 μm pixel
Linienrate bis 46 kHz, verschiedene Betriebsmodi